

### Материалознание

доц. Боянка Николова

каб. 1301

Приемно време: понеделник от 11.00 ч. до 13.00 ч. вторник от 10.30 ч. до 11.30 ч.

e-mail: bnikol@tu-sofia.bg

Лабораторни упражнения – от първа седмица



### Материалознание

Класификация на материалите.

Експлоатационни условия и изисквания към материалите.

Поляризация, електропроводимост, загуби, пробив и физически свойства на диелектричните материали.

Основни свойства на материалите с електронна проводимост.

Собствени и примесни полупроводници. Методи за определяне на типа на примесната проводимост.

Основни свойства на магнитните материали - намагнитване, магнитна проницаемост, хистерезисен цикъл, загуби на енергия.

Полимерни диелектрични материали. Електроизолационни компаунди и лакове. Неорганични диелектрични материали.

Метали и сплави с висока проводимост. Благородни метали. Припои и флюсове. Сплави с високо съпротивление.

Полупроводникови материали.

Магнитномеки метали и сплави. Ферити и магнитодиелектрици.

Резистори - параметри. Жични, слойни и композиционни резистори. Полупроводникови нелинейни резистори.

Кондензатори - параметри. Кондензатори с органичен и неорганичен диелектрик. Електролитни кондензатори.



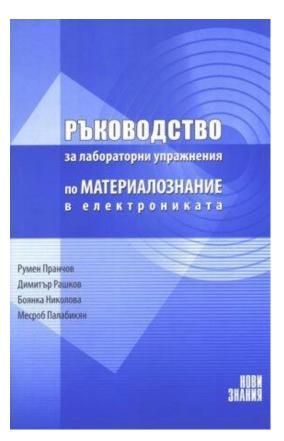
### Материалознание

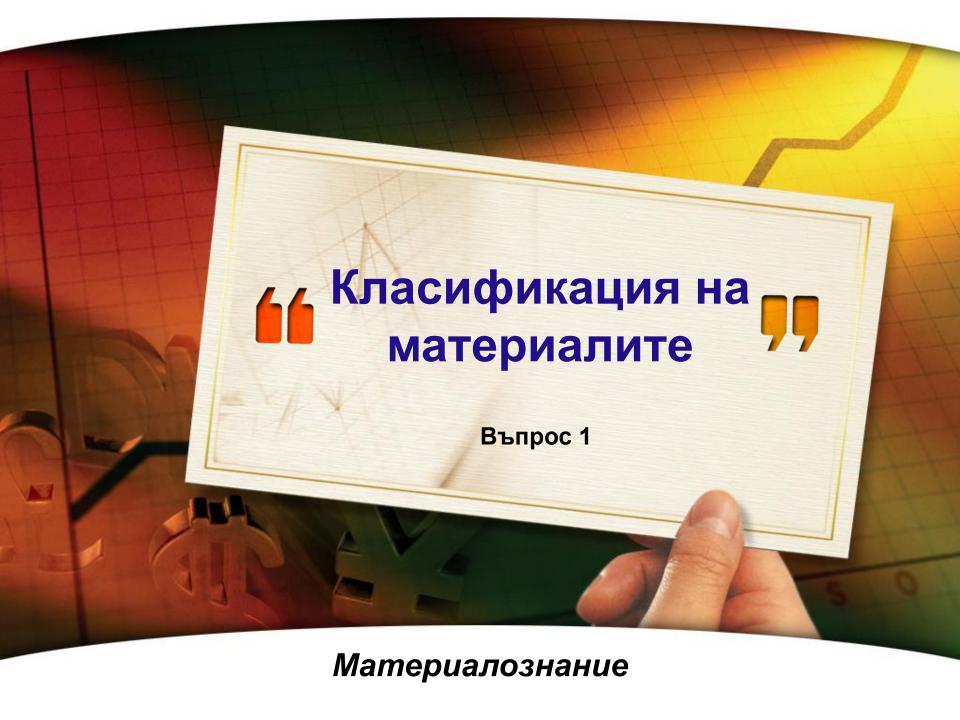
#### Литература:

Пранчов, Р., "Материалознание в електрониката", София, "Нови знания", 2005.

Пранчов, Р., Д. Рашков, Б. Николова, М. Палабикян, "*Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката*", София, "Нови знания", 2005.









### Съдържание



Строеж на материалите



Класификация на материалите



Примерни приложения



#### 1. Енергетична (енергийна) диаграма на атома

Основни принципи на квантовата механика:

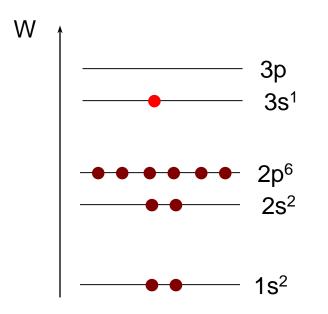
- ▶ Отделните атоми имат дискретен енергиен спектър електроните им могат да заемат само определени нива;
- ▶ Принцип на Паули не могат да съществуват два електрона с напълно еднаква енергия.



#### 1. Енергетична (енергийна) диаграма на атома

Na (11) 
$$\rightarrow$$
 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup>

Ne (10) 
$$\to$$
 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup>



Енергетична диаграма на Na в равновесно състояние



#### 2. Видове химични връзки

В зависимост от природата си връзките биват:

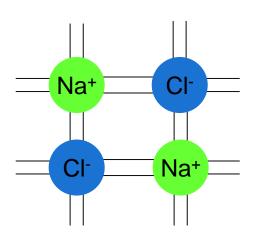
- Първични (между атоми) йонна, ковалентна и метална
- Вторични (между молекули) Ван дер Валсова

Енергията на връзката определя физическите свойства на материалите.



### 2.1. Йонна връзка

Възниква от прехода на валентни електрони от един атом към друг.



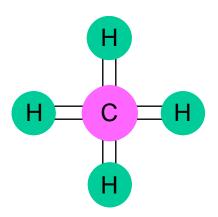
Енергия на връзката – много висока (от 650 до 1000 kJ/mol)

Йонен кристал на NaCl



#### 2.2. Ковалентна връзка

Обединяването на атоми в молекули става чрез електрони, които стават общи. Представители – H<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O и други.



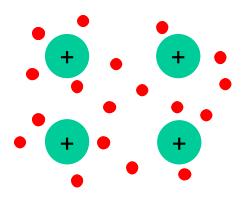
Енергия на връзката – висока (от 450 до 700 kJ/mol)

Молекула на СН₄ (метан)



#### 2.3. Метална връзка

Възниква между положителните метални ядра и колективните (валентни) електрони.

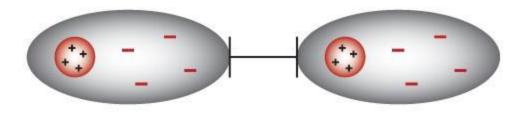


Енергия на връзката – висока (от 70 до 800 kJ/mol)



#### 2.4. Ван дер Ваалсова връзка

Универсална и теоретично може да възникна между всеки две частици, но на практика се установява между атомите на инертните газове и при някои органични материали.

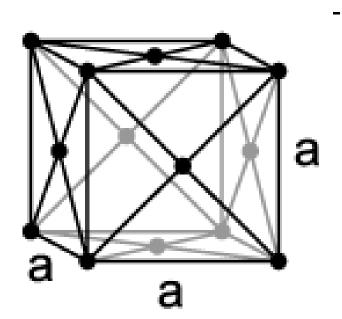


Енергия на връзката – ниска (до 30 kJ/mol)



- 3. Особености в строежа на твърдото тяло
- 3.1. Кристални вещества

Градивните им частици образуват кристална решетка, в която може да се отдели основна градивна клетка.



Кубична стенноцентрирана решетка



#### 3.1. Кристални вещества

a ≠ c

Тетрагонална обемноцентрирана решетка

Кристалните тела могат да бъдат:

- ✓ Монокристали представляват един кристал;
- ✓ Поликристални състоят се от много, различноориентирани кристали.



#### 3.2. Аморфни вещества

Случайно, хаотично разположени градивни частици.

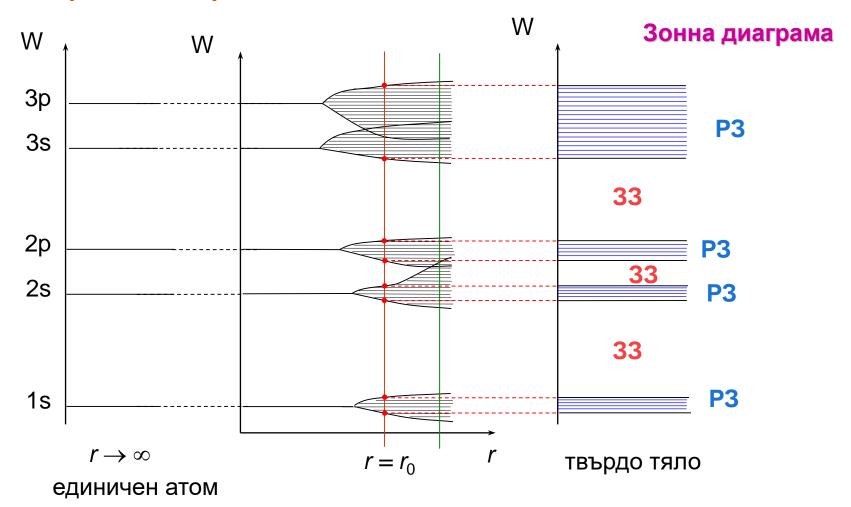
#### 3.3. Изотропност и анизотропност

**Изотропни вещества** – свойствата им са еднакви във всички посоки. Такива са аморфните и поликристалните тела.

Кристалите проявяват *анизотропност* – свойствата им зависят от кристалографската ориентация на решетката им.



#### 4. Зонна теория на твърдото тяло





#### Особености:

- Броят на енергетичните нива във всяка зона е равен на броят на атомите в кристала;
- Широчината на зоните не зависи от броя на атомите, а от взаимодействието между тях.

Ако материалът има идеална кристална решетка и се намира при абсолютна температурна нула, то се дефинират следните зони:

**Валентна зона** (ВЗ) – в нея са разположени всички валентни електрони т. е. всички енергетични нива са заети;

Свободна зона (СЗ) – получена от разрешени и незаети нива;

**Забранена зона** (33) – енергетичен интервал между ВЗ и СЗ, в който няма разрешени нива.

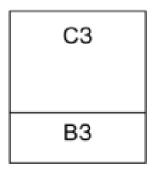


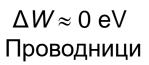
### II. Класификация

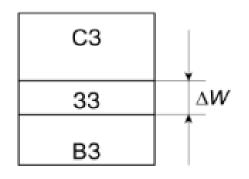
#### 1. Според електрическите свойства на материалите

Материалите се разделят на проводници, диелектрици и полупроводници.

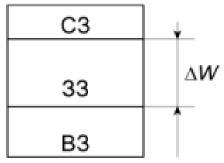
#### 1.1. Съгласно зонната теория (широчината на забранената зона *∆W*)









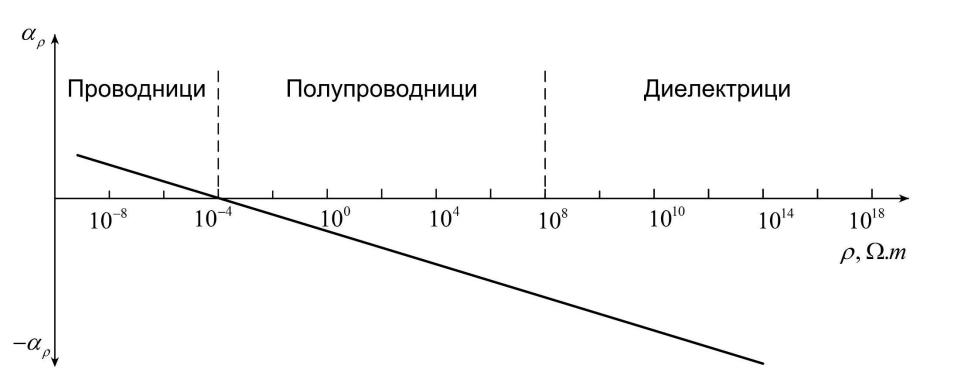


 $\Delta W > 3 \text{ eV}$ Диелектрици



### II. Класификация

#### 1.2. Съгласно специфично съпротивление $\rho$





### II. Класификация

#### 2. Според магнитните свойства на материалите

2.1. Немагнитни (µ<sub>r</sub> ≈ 1):

Диамагнетици  $\mu_r < 1$ 

Парамагнетици  $\mu_r > 1$ .

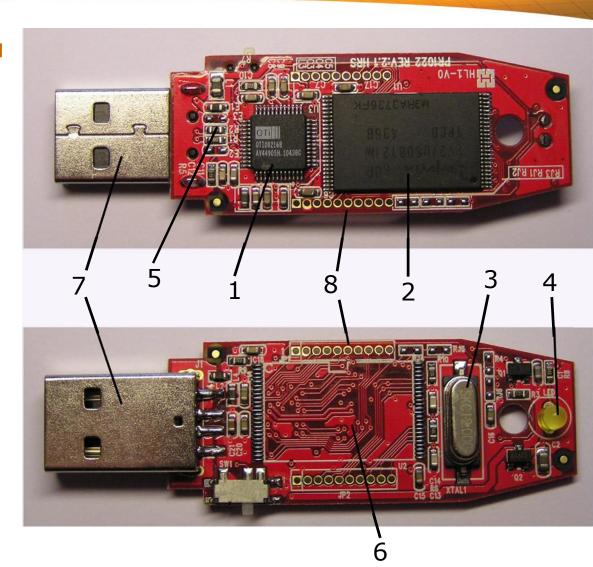
2.2. Магнитни – Феромагнетици  $\mu_r >> 1$ .



#### Микропроцесорни системи

USB флаш (USB *flash drive*)

- 1 USB контролер
- 2 Флаш-памет
- 3 Кварцов резонатор
- 4 Светодиод
- 5 Резистори и кондензатори
- 6 Печатна платка
- 7 USB съединител
- 8 Тестови точки





#### USB контролер

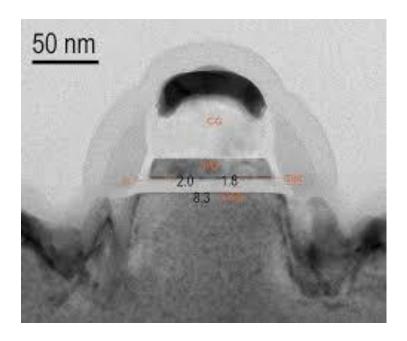
Микроконтролерът е интегрална схема, съчетаваща в себе си микропроцесор, тактов генератор, оперативна памет и входно-изходни устройства, което ѝ позволява да функционира като самостоятелно компютърно устройство.

Интегрална схема е електронна схема с миниатюрни размери, състояща се от **полупроводникови** устройства и пасивни компоненти, която е реализирана обикновено върху тънък кристал от **силиций или друг полупроводник**.



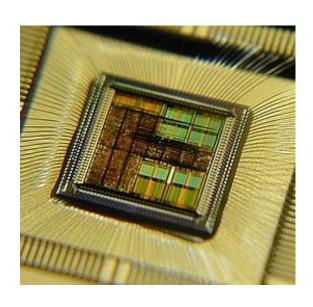
**Флаш-памет** - Електрически препрограмируема памет, която се реализира върху **полупроводникови чипове** по планарна технология

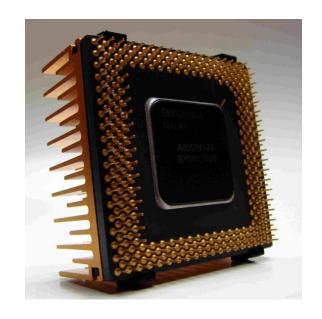
За запомняща клетка се използва MOS транзистор с плаващ гейт.





Свръх големи интегрални схеми (VLSI – Very large-scale integration)





Проводящи метали малко съпротивление и отлични физически свойства

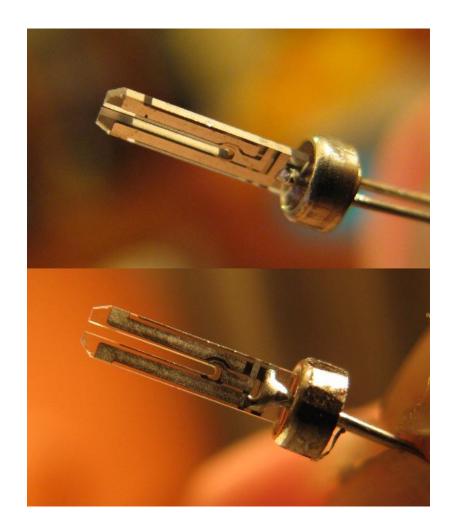
**Диелектрични материали** с отлични топлопроводимост и физически свойства



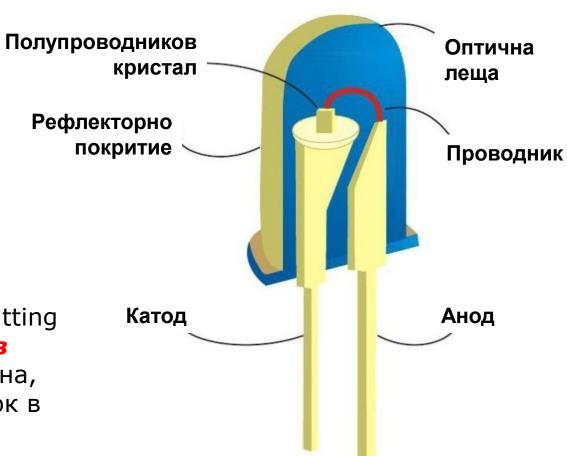
**Кварцов резонатор** – генератор на трептения с еталонна честота.

Електромеханична трептяща система, състояща се от пластина от *кварцов кристал*, върху която са нанесени *метални* електроди.









**Светодиод** (LED – light-emitting diode) – *полупроводников* диод, който излъчва светлина, когато през него протича ток в права посока.

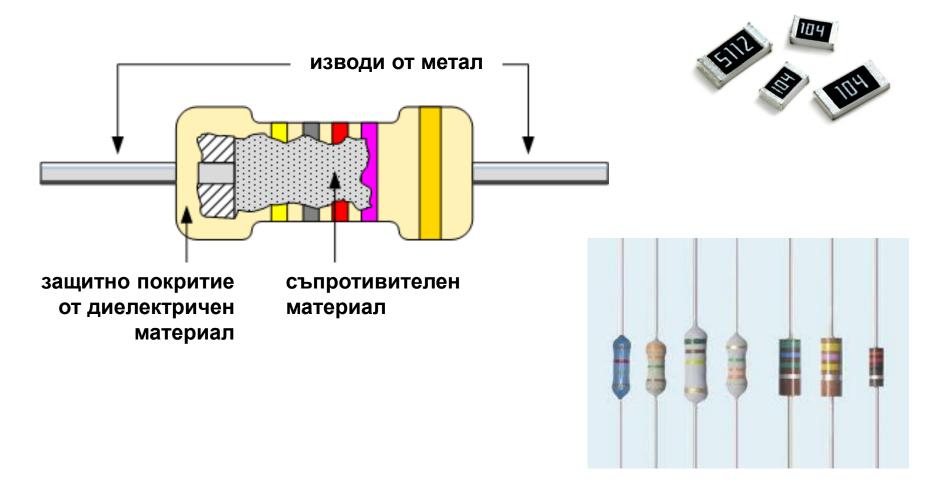


#### Светодиод



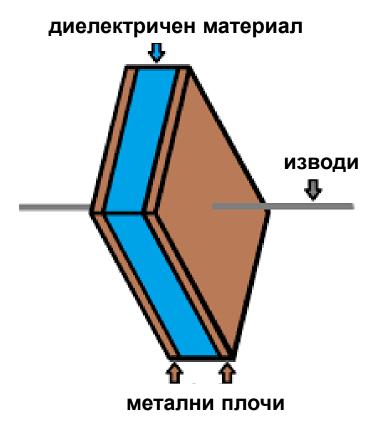


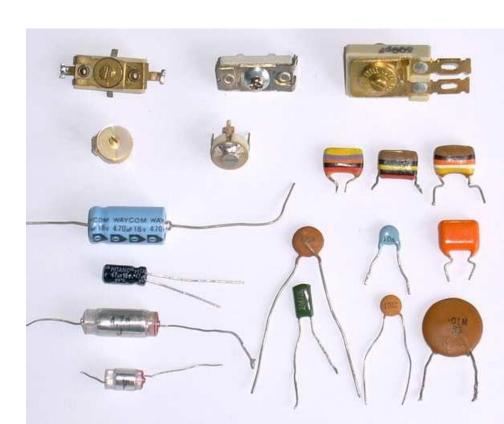
#### Резистор





#### Кондензатор







**Печатна платка** – пластина от *диелектрик*, върху която чрез *проводящ материал* са оформени електрически връзки, за реализиране на различни електронни схеми.



